

2SC3025, 2SC3026

シリコン NPN 三重拡散形

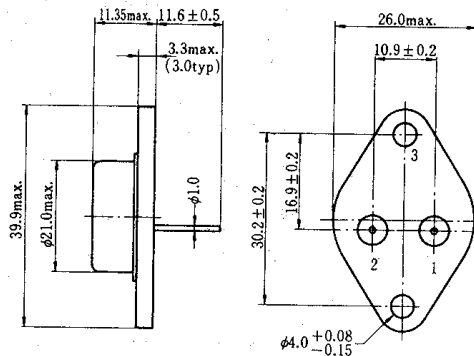
高電圧電力スイッチング

キャラクタディスプレイ水平偏向出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

HIGH VOLTAGE POWER SWITCHING

CHARACTER DISPLAY HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT



(JEDEC TO-3)

1. ベース : Base
 2. エミッタ : Emitter
 3. コレクタ : Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

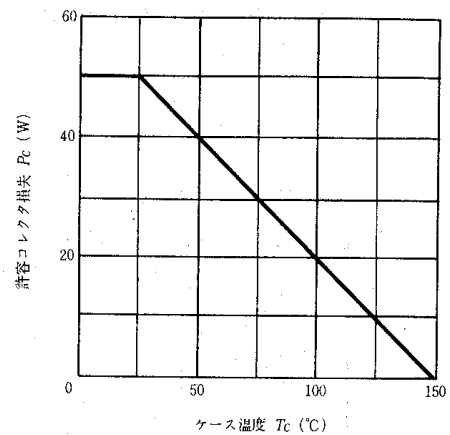
項目	Symbol	2SC3025	2SC3026	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	1500	1700	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	800	800	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	6	6	V
コレクタ電流	I_C	5	5	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	6	6	A
コレクタサージ電流	$i_{C(surge)}$	16	16	A
許容コレクタ損失	P_C^*	50	50	W
接合部温度	T_j	150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-45 ~+150	-45 ~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化

MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{BR(CEO)}$	$I_C=10\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$	800	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{BR(EBO)}$	$I_E=10\text{mA}$, $I_C=0$	6	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CES}	2SC3025	—	—	0.5	mA
		2SC3026			0.5	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5\text{A}$, $I_B=1.25\text{A}^*$	—	—	2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=5\text{A}$, $I_B=1.25\text{A}^*$	—	—	1.5	V
下降時間	t_f	$I_C=5\text{A}$, $I_{B1}=1.0\text{A}$	—	—	0.5	μs
蓄積時間	t_{stg}	$I_{B2}=-2.5\text{A}$	—	4	—	

*パルス測定

* Pulse Test

Silicon NPN Power Transistors

2SC3026

DESCRIPTION

- With TO-3 package
- High breakdown voltage

APPLICATIONS

- High voltage power switching character display horizontal deflection output

PINNING(see Fig.2)

PIN	DESCRIPTION
1	Base
2	Emitter
3	Collector

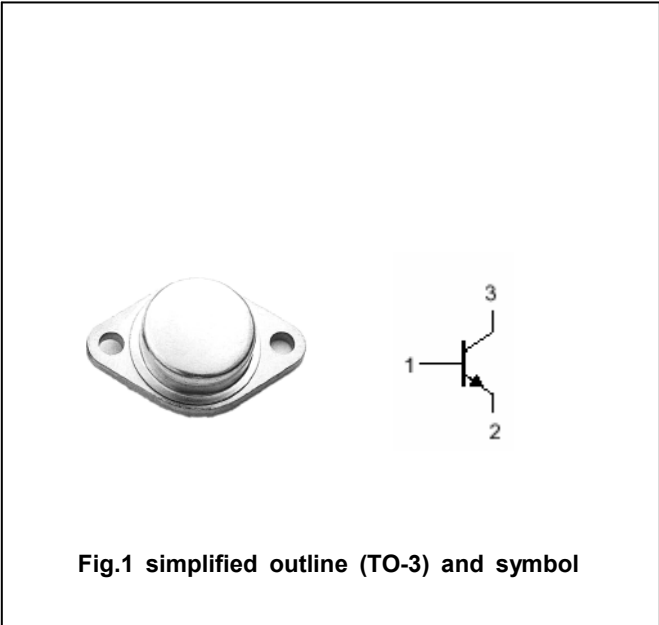


Fig.1 simplified outline (TO-3) and symbol

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(T_a=25℃)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	VALUE	UNIT
V _{CBO}	Collector-base voltage	Open emitter	1700	V
V _{CEO}	Collector-emitter voltage	Open base	800	V
V _{EBO}	Emitter-base voltage	Open collector	6	V
I _C	Collector current		5	A
I _{CP}	Collector current-peak		6	A
P _C	Collector power dissipation	T _C =25℃	50	W
T _j	Junction temperature		150	℃
T _{stg}	Storage temperature		-45~150	℃

Silicon NPN Power Transistors

2SC3026

CHARACTERISTICS

T_j=25 °C unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP.	MAX	UNIT
V _{(BR)CEO}	Collector-emitter breakdown voltage	I _C =10mA ; R _{BE} =∞	800			V
V _{(BR)EBO}	Emitter-base breakdown voltage	I _E =10mA; I _C =0	6			V
V _{CE(sat)}	Collector-emitter saturation voltage	I _C =5A; I _B =1.25A			2.0	V
V _{BE(sat)}	Base-emitter saturation voltage	I _C =5A; I _B =1.25A			1.5	V
I _{CES}	Collector cut-off current	V _{CE} =1700V; R _{BE} =∞			0.5	mA

Switching times

t _s	Storage time	I _C =5A; I _{B1} =1A; I _{B2} =-2.5A		4.0		μs
t _f	Fall time				0.5	μs

PACKAGE OUTLINE

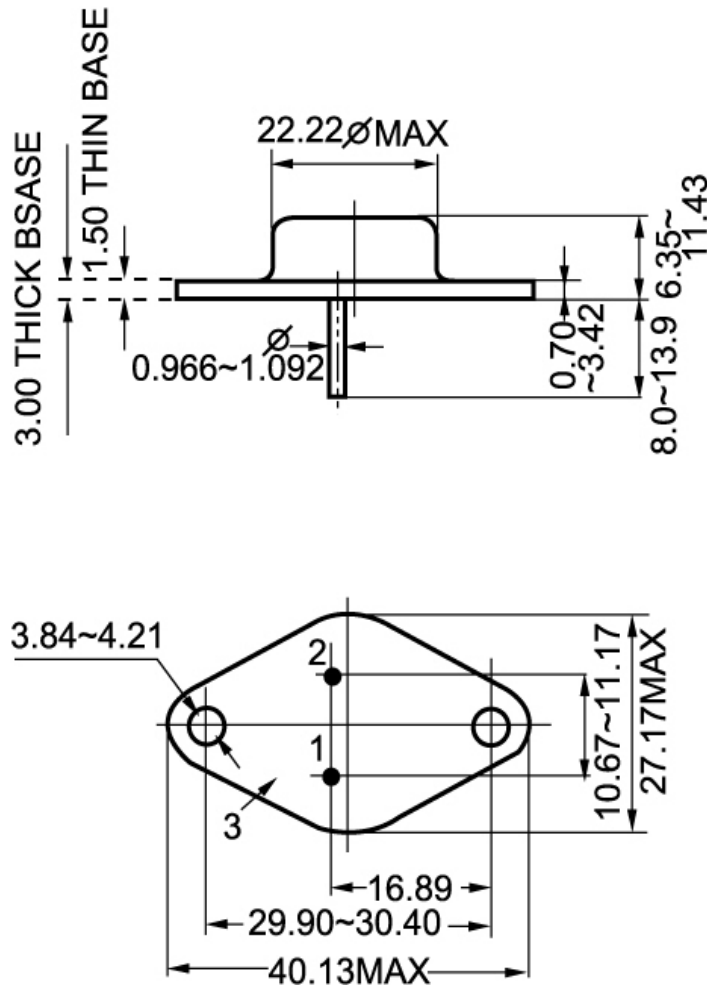


Fig.2 outline dimensions (unindicated tolerance:±0.1mm)